# (FOR JP 2-46691B2) PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

60-054999

(43) Date of publication of application: 29.03.1985

(51) Int. CI.

C30B 29/62

C30B 29/02

// C01B 31/02

D01F 9/12

(21) Application number: 58-162607 (71) Applicant: NIKKISO CO

LTD

(22) Date of filing:

06.09.1983 (72) Inventor:

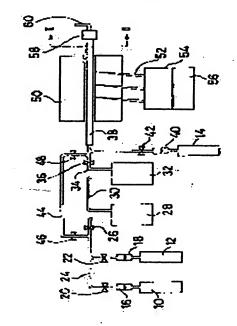
**ARAKAWA** 

KOHEI

# (54) PRODUCTION OF CARBON FIBER GROWN IN VAPOR PHASE

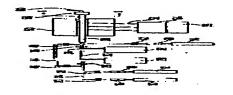
## (57) Abstract:

PURPOSE: A carrier gas containing a carbon compound, an organosilicon compound and hydrogen sulfide is heated to achieve high-efficiency production of carbon fibers by the vapor phase growth process. CONSTITUTION: The inside of the reactor tube 38 is replaced with N2 gas by purging it fed from bomb 12 through by-path 44. Then, H2 from bomb 10, as a carrier gas, is sent to the



THIS PAGE BLANK (USPTO)

generator 28 containing a carbon compound such as benzene and the other generator 32 containing an organosilicon compound such as



diethylsilane. The resultant carrier gas is combined with hydrogen sulfide gas from bomb 14, then sent to the reactor 38 where the gas is heated with an electric furnace 50 at about 700W1,300° C to allow carbon fibers to grow in vapor phase.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## PRODUCTION OF CARBON FIBER GROWN IN VAPOR PHASE

Patent number:

JP60054999

Publication date:

1985-03-29

Inventor: Applicant: ARAKAWA KOUHEI NITSUKISOU KK

Classification:

- international:

C30B29/62; C30B29/02

- european:

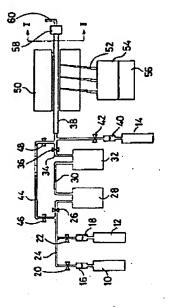
Application number: JP19830162607 19830906

Priority number(s):

#### Abstract of JP60054999

PURPOSE:A carrier gas containing a carbon compound, an organosilicon compound and hydrogen sulfide is heated to achieve high-efficiency production of carbon fibers by the vapor phase growth process.

CONSTITUTION: The inside of the reactor tube 38 is replaced with N2 gas by purging it fed from bomb 12 through by-path 44. Then, H2 from bomb 10, as a carrier gas, is sent to the generator 28 containing a carbon compound such as benzene and the other generator 32 containing an organosilicon compound such as diethylsilane. The resultant carrier gas is combined with hydrogen sulfide gas from bomb 14, then sent to the reactor 38 where the gas is heated with an electric furnace 50 at about 700-1,300 deg.C to allow carbon fibers to grow in vapor phase.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(1) 特許出願公告

#### 許 公 報(B2) @特

平2-46691

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

**6000**公告 平成2年(1990)10月17日

8/127 D 01 F 01 B 31/04 29/02 29/62 C 30 B D 01 F 9/133

6791-4L 6345-4 G 8518-4 G 8518-4 G 6791-4L

発明の数 4 (全6頁)

❷発明の名称

気相成長炭素繊維の製造法

の特 顧 昭58-162607 ❷公 第 昭80-54999

顧 昭58(1983)9月6日 を出

49昭60(1985)3月29日

荒 川 公 平 砂発 明 者

東京都渋谷区恵比斑3丁目43番2号 日機装株式会社内

日機裝株式会社 東京都渋谷区恵比寿3丁目43番2号 **创出 順 人** 

四代 理 人 弁理士 浜田 治雄

審 査 官 船越

巧 子 特開 昭57-89663 (JP, A)

特開 昭56-118913 (JP, A)

特公 昭58-31430(JP, B2)

特公 昭54-35199 (JP, B2)

1 -

#### の特許請求の範囲

四多考文献

1 硫黄および炭素含有ケイ素化合物のガスとキ ヤリヤガスとの混合ガスを温度コントロールした 反応帯域に連続的に導入し、所定温度に加熱する れを連続的に加熱域から流出させることを特徴と する気相成長炭素繊維の製造法。

- 2 硫黄含有ケイ素化合物のガスとキャリヤガス と炭素化合物との混合ガスを温度コントロールし た反応帯域に連続的に導入し、所定温度に加熱す 10 〔従来技術とその問題点〕 ることにより、浮遊状態で炭素繊維を生成させ、 これを連続的に加熱域から流出させることを特徴 とする気相成長炭素繊維の製造法。
- 3 炭素含有ケイ素化合物のガスとキャリヤガス した反応帯域に連続的に導入し、所定温度に加熱 することにより、浮遊状態で炭素繊維を生成さ せ、これを連続的に加熱域から流出させることを 特徴とする気相成長炭素繊維の製造法。
- 素ガスと炭素化合物のガスとの混合ガスを温度コ ントロールした反応帯域に連続的に導入し、所定 温度に加熱することにより、浮遊状態で炭素繊維 を生成させ、これを連続的に加熱域から流出させ

2

#### 発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野)

本発明は、気相中で連続的に炭素繊維を製造す る方法に関し、更に詳細には、炭素供給源、ケイ ことにより、浮遊状態で炭素繊維を生成させ、こ 5 素供給源、硫黄供給源(それらの内2種は、両元 素を含有した一化合物であつてもよい)とキャリ ヤガスとからなる混合ガスを700℃から1300℃の 範囲で加熱することを特徴とする気相成長炭素繊 維の製造法に関する。

気相成長炭素繊維は、高強度、高弾性、高導電 性、高耐食性、高生体適合性などの優れた特性を 有し、特に機械的特性を例にとれば、すでに商品 化されているPAN系炭素繊維、ピッチ系炭素繊 と硫化水素ガスとの混合ガスを温度コントロール 15 維、レーヨン系炭素繊維性能を遥かに陵駕するも のであり、理想的素材と含える。

従来、気相成長炭素繊維は、電気炉内にアルミ ナなどの磁器、黒鉛などの基板を置き、これに 鉄、ニツケルなどの超微粒子触媒を形成せしめ、 4 ケイ素化合物のガスとキャリヤガスと硫化水 20 この上にペンゼンなどの炭化水素のガスと水素キ ヤリヤガスの混合ガスを導入し、1010~1300℃ の温度下に炭化水素を分解せしめることにより、 基板上に炭素繊維を成長させる方法が知られてい る。基板上に上記炭素成長核、超微粒子触媒を形 ることを特徴とする気相成長炭素繊維の製造法。 25 成させる方法は、基板に、鉄、ニツケルまたはそ

れらの合金の100人程度の超微粒子を懸濁させた アルコール懸濁液をスプレーするかまたは塗布し て乾燥することである。また、前記懸濁液に代え て硝酸鉄水溶液を基板に塗布して乾燥させてもよ れ、ペンゼンや水素を加えて1010℃~1300℃に加 熱すれば、還元と成長が進行する。

場合によつては積極的に基板上に触媒を生成さ せなくても、不純物として基板や反応管に付着も 成して、研究者が触媒の存在を意識していない場 合もある。

ただし、いずれにしても繊維は触媒により生成 しているので、触媒を保有する基板もしくは反応 管から生えており、反応管からは出てこない。

しかし、このような方法では、①基板表面の微 妙な温度ムラや、周囲の繊維の密生度によって長 さの不均一が起り易いこと、また②炭素の供給源 としてのガスが反応によつて消費されることによ り反応管の入口に近い所と出口に近い所で繊維径 20 が相当異なること、③基板表面でのみ生成が行な われるため、反応管の中心部分は反応に関与せず 収率が悪いこと、④超微粒子の基板への分散、還 元、成長次いで繊維の取出しという独立に実施を 能であり、従つて生産性が悪いなどの問題点を有 する。そのため、コスト面において、すでに商品 化されているPAN系炭素繊維、ピッチ形炭素繊 維、レーヨン系炭素繊維に対抗することは、特殊 な用途を除いて不可能と言える。

#### 〔発明の目的〕

それ故、この発明の一般的な目的は、上述の間 題点を除去し、生産性を高めることのできる気相 成長炭素繊維の連続製造方法を提供するにある。

を大幅に伸し、気相成長炭素繊維が炭素繊維の主 役を占めることを可能にすることである。

#### 〔発明の要点〕

この目的を違成するため、この発明に係る気相 イ案化合物のガスとキャリヤガスとの混合ガスを 温度コントロールした反応帯域に連続的に導入 し、所定温度に加熱することにより、浮遊状態で 炭素繊維を生成させ、これを連続的に加熱域から

流出させることを特徴とする。

また別法として、硫黄含有ケイ素化合物のガス とキャリヤガスと炭素化合物との混合ガスを温度 コントロールした反応帯域に連続的に導入し、所 い。次いで、前記基板を電気炉内の反応管に入 5 定温度に加熱することにより、浮遊状態で炭素繊 維を生成させ、これを連続的に加熱域から流出さ せることを特徴とする。

また別法として、炭素含有ケイ素化合物のガス とキャリヤガスと硫化水素ガスとの混合ガスを温 しくは包含されている粒子を触媒として繊維を生 10 度コントロールした反応帯域に連続的に導入し、 所定温度に加熱することにより、浮遊状態で炭素 繊維を生成させ、これを連続的に加熱域から流出 させることを特徴とする。

> また別法として、ケイ素化合物のガスとキャリ 15 ヤガスと硫化水素ガスと炭素化合物のガスとの混 合ガスを温度コントロールした反応帯域に連続的 に導入し、所定温度に加熱することにより、浮遊 状態で炭素繊維を生成させ、これを連続的に加熱 域から流出させることを特徴とする。

本発明における炭素供給源としての炭素化合物 とは、有機鎖式化合物または有機環式化合物から なる有機化合物全般が対象となるが、特に高い収 率を得るには脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素で ある。しかし、炭化水素化合物以外に窒素、酸 必要とするプロセスがあるため、連続製造が不可 25 素、硫黄、弗素、塩素、臭素、沃素、嬶、砒素の 内の一種類以上の元素を含むものも使用できる。 これらの元素は含まない方が良好であるが、特に 硫黄については問題が少ないため、炭素と水素と 硫黄との組合せからなる場合には好適である。具 30 体的な個々の化合物の例を挙げると、メタン、エ タン等のアルカン化合物、エチレン、プタジェン 等のアルケン化合物、アセチレン等のアルキン化 合物、ペンゼン、トルエン、スチレン等のアリー ル炭化水素化合物、インデン、ナフタリン、フェ 本発明の別の目的は、気相成長炭素繊維の需要 35 ナントレン等の縮合環を有する芳香族炭化水素、 シクロプロパン、シクロヘキセン等のシクロオレ フィン化合物、ステロイド等の縮合環を有する脂 環式炭化水素化合物、メチルチオール、メチルエ チルスルフイド、ジメチルチオケトン等の含硫脂 成長炭素繊維の製造法は、硫黄および炭素含有ケ 40 肪族化合物、フェニルチオール、ジフェニルスル フィド等の含硫芳香族化合物、ペンゾチオフェ ン、チオフエン等の含硫複素環式化合物等であ る。また、以上の化合物の2種以上を混合した混 合物を使用することも可能である。

本発明におけるガスとは、純ガス体以外にガス 体に固体または液体の微粒子を包含する煙霧質も 含める広義のガス体を意味するものとする。

キャリヤガスとしては、周期律表 0 族のアルゴ ン、ヘリウム等の希ガスおよび水素、窒素または 5 これらの混合ガスの中から選択されるガスであ り、水素ガスが最も好ましい。水素ガス以外のガ スをキャリヤガスとして使用する場合、一般に炭 素化合物の熱分解が促進されすぎ、かえつて炭素 物の濃度を大幅に低下させる必要性がでてくる。

本発明における有機ケイ素化合物とは、ケイ素 一炭素結合をもつ有機化合物の他にシラン、ハロ ゲンシランを便宜上含むものとする。炭素ーケイ シラン、メチルトリフェニルシラン等のオラガノ シラン、クロルジフルオルメチルシラン、プロム トリプロピルシラン等のオルガノハロゲンシラ ン;メトキシトリメチルシラン、トリメチルフェ アセトキンジメチルシラン、アセトキシトリプロ ピルシラン等のオルガノアセトキシシラン:ヘキ サエチルジシラン、ヘキサフエニルジシラン、オ クタフエニルシクロテトラシラン等のオルガノポ 等のオルガノヒドロゲノシラン;(SiH<sub>2</sub>)。で表示 されるシクロシラン;トリフエニルシラザン、ヘ キサエチルジシラジン、ヘキサフエニルシクロト リシラザン等のオルガノシラザン;(SiH2NH)。 オール、トリフエニルシラノール等のオルガノシ ラノール;トリメチルシリル酢酸、トリメチルシ リルプロピオン酸等のオルガノシランカルポン 酸:トリメチルシリコンイソシアナート、ジフェ シアナート;トリメチルシリコンイソチオシアナ ート、ジブエニルシリコンジイソチオシアナート 筝のオルガノシリコンイソチオシアナート;シア ン化トリエチルシリル等のオルガノシリコンエス シクロジシルチアン等のシルチアン;(SiH.S)。 で表示されるシクロシルチアンドペキサメチルジ シルメチレン、オグタメチルトリシルメチレン等 のポルガノシルメチレン:ヘキザメチルジシロキ

6

サン、ヘキサプロピルジシロキサン等のオルガノ シロキサン等が挙げられるが、その他の皮素ーケ イ素結合を含む化合物であつてもよい。また、こ れらの混合物の使用も可能である。

本発明を具体的に説明すると、炭素化合物のガ スと有機ケイ素化合物のガスと少量ガスを含むキ ヤリヤガスとの混合ガスを好適には700℃~1300 ℃、更に好適には1050℃~1200℃で加熱すること による炭素繊維を生成する方法に関する。炭素化 繊維の生成を阻害する原因になるため、炭素化合 10 合物、有機ケイ素化合物が液体若しくは固体の場 合それを加熱蒸発若しくは昇華によってガス化す る。炭素化合物のガス及び有機ケイ素化合物のガ スの全混合ガス中に占める割合は、好ましくは 各々0~40%、0.01~40%、更に好ましくは各々 素結合を持つ有機化合物としては、テトラメチル 15 0.5~10%、0.05~10%である。炭素化合物のガ スが0%でも良い理由は、有機ケイ素化合物中に 十分な炭素を含んでいる場合があるためである。 また、キヤリヤガスには好ましくは0~20%の硫 化水素ガスを混合するが、有機ケイ素化合物中若 ノキシシラン等のオルガノアルコキシシラン;ジ 20 しくは炭素化合物中に破黄原子が含まれている場 合には、必ずしも硫化水素ガスを必要としない。 しかし、好ましくは1~10%、最も好ましくは2 ~5%含むのが良い。

本発明において、炭素供給源としての炭素化合 リシラン:ジメチルシラン、トリフエニルシラン 25 物のガスと有機ケイ素化合物のガスと硫化水素ガ スを含むキャリヤガスとの混合ガスを熱分解する ことによつて炭素繊維が生成されたという事実か ら判断し、触媒として機能できるケイ紊もしくは ケイ素化合物粒子が生成し、加熱帯域を流動しな で表示されるシクロシラザン;ジエチルシランジ 30 がら炭素繊維を生成・成長させているものと判断 する。

また、本発明は、鉄、ニツケル、コバルトまた はそれらの合金の超微粒子や硝酸鉄、硫酸第1鉄 のように、従来気相成長炭素繊維の触媒として知 ニルシリコンジイソシアナート等のシリコンイソ 35 られていた金属または金属化合物では、下記の理 由で気相触媒として試みられたことがなく、有機 ケイ素化合物を試みて気相成長炭素繊維の製造が 可能となつたものである。すなわち、鉄の超数粒 子を気相中に分散させる場合、第一に超微粒子を テル:ヘキサメチルジシルチアン、テトラメチル 40 定量的に微少量送るフィーダを設けることが技術 的に難しいこと、第二に前記超微粒子の供給が可 能であつても超微粒子はエネルギ的に安定な凝集 二次粒子を作るため、炉内に入ると、塵ちに焼結 し、触媒効果を発揮できないような大きな粒子に

なること、第三に超微粒子は表面エネルギが高い ため非常に活性で酸化鉄の状態にあるため、源元 の必要性があるが、炭素供給ガスとの混合ガスに なっているため、運元前に炭素の表面沈着が起 り、実質的に触媒として機能しなくなる等の理由 5 で不可能である。硫酸鉄や硫酸第1鉄の場合、窓 気を得ることが容易でなく、鉄のように超微粒子 を作成する方法が考えられるが、超微粒子となる とやはり鉄の場合と同様の問題に直面し、不可能

有機ケイ素化合物を使用し、それを蒸発し気相 中で触媒を生成するという新しい手法によつて触 媒の基板への分散と源元という2つのプロセスを 省略することを可能としたもので、これによつて ケイ素化合物のガスを熱分解することにより、触 媒と炭素繊維を連続的に生成させることが可能と なつた。

また、本発明によれば、従来のように反応が基 い収率が得られる。気相中で生成している炭素繊 維は、浮遊運動をしているため、各繊維は平均的 に同一条件で生成していると考えてよく、生成炭 素繊維はアスペクト比の均一なものが得られる。

の線速度、電気炉の温度を制御することにより、 アスペクト比を変えることが容易である。実験に よると1100℃以下では主として畏さ成長が起り、 1100℃を超えると主として径の成長が目立つてく 素繊維の長さが混合ガスの炉内の滞留時間にほぼ 比例するため、1100°C以下の加熱炉と1100°Cを超 える加熱炉とを直列に接続することによつて、前 者で長さ成長を完了し、後者で太さ成長を行い、 統的に生成することが可能である。特に従来の炭 素繊維からは得ることができなかつた長さ0.24~ 2000μ、径0.03μ~10μの範囲のアスペクト比一定 の短い炭素繊維を高い収率で連続的に製造するこ する複合材料という用途を検討した場合、高強 度、高弾性でアスペクト比100~200が好ましいと いうことが言われており、本発明がアスペクト比 を自由にコントロール可能であり、特にアスペク

ト比100~200は極めて容易に作成でき、気相成長 炭素繊維特有の高強度、高弾性という機械的特性 を有するという点で、複合材料には理想的素材と 育える。

#### 〔発明の実施例〕

次に、この発明に係る気相成長炭素繊維の製造 方法の好資な実施例につき添付図面を参照しなが ら以下詳細に説明する。

まず、本発明における気相成長炭素繊維を製造 10 するために使用した装置につき、その観略を示せ ば、第1図および第2図に示す通りである。

第1図において、参照符号10, 12, 14は ガスポンペを示し、それぞれポンペ10には高純 度水素ガス、ポンペ12には窒素ガス、ポンペ1 気相中で炭素源としての炭素化合物のガスと有機 15 4には硫化水素ガスが充填される。ポンペ10, 12は、それぞれ流量計16、18およびパルブ 20, 22を介してステンレスパイプ24に接続 されている。このパイプ24は、パルプ26を介 してペンゼンを充塡した原料ガス発生器28に違 板表面だけでなく、全域にわたつているため、高 20 通している。また、この原料ガス発生器2.8から ステンレスパイプ30が導出され、このパイプ3 □はジエチルシランを充塡したガス発生器32に 連通している。さらにこのガス発生器 3 2 からス テンレスパイプ34が導出され、このパイプ34 更に、本発明によれば、装置の大きさや、ガス 25 はパルプ38を介して反応管38に違通してい る。しかるに、この反応管38に連通する前記パ イブ34の一部に前記ポンペ14が流量計40お よびパルブ42を介して接続されている。なお、 前述したパイプ24からパルプ28より両ガス発 る。また、長さの成長範囲においては生成する炭 30 生器28。32およびパルプ36を介して反応管 38に接続されるパイプ34に至る系に対し、ス テンレスパイパスパイプ44をそれぞれパルプ4 8,48を介して接続する。

反応管38は、例えば内径22点、長さ1200点の 結果として希望するアスペクト比の炭素繊維を連 35 アルミナ管で構成し、その長さ約600mに頂つて これを電気炉50内に設置する。この電気炉50 の温度は、熱電対52と3回転PID温度制御器5 4とからなる制御系で制御し、この温度は温度配 録計56で記録するよう構成する。 そして、前記 とが可能である。また、短繊維をランダムに充填 40 反応管38の終始部にはステンレス繊維フイルタ 58を介して排気パイプ60を連通する。

> このように構成した装置は、運転に際し、最初 ポンペ12から供給される窒素ガスをパイパスパ イブ44を介して反応管38に供給し、反応管3

8内部を窒素ガスで置換して爆発の危険を防止す る。次いで、ポンペ10より水素ガスを両ガス発 生器28,32に順次供給して水素-ペンゼン-ジエチルシランの混合ガスとなし、これをさらに 5 8 の作用下に反応管 3 8 内に予め収納した触媒 に対し炭素繊維の気相成長が行われ、得られた炭 紫嶽維はステンレス繊維フイルタ58に捕集され **5.** 

る装置を示すものである。すなわち、第2図にお いて、参照符号82は第2の反応管を示し、この 第2の反応管62は内径85元、長さ約1700元のア ルミナ管で構成し、第1図に示す第1の反応管3 管62の入口部に対し、アセチレンガスをさらに 混合し得るように構成する。このため、アセチレ ンガスを充填したガスポンペ84を設け、このポ ンペを流量計86およびパルプ68を介して前記 反応管62の入口部に設けた栓部材70に接続す 20 ℃換算の液量。 る。また、第2の反応管82は、第1の反応管3 8と同様に、電気炉72、熱電対74、3回路 PID温度制御器 7 6、温度配録計 7 8、ステンレ ス繊維フイルタ80および排気パイプ82を設け る。なお、この場合、第1の反応管38に対して 25 は、ステンレス繊維フイルタ58および排気パイ プ80が省略されることは勿論である。 実施例 1

第1図に示す装置において、ポンペ10に高純 度水素ガス、ポンペ14に硫化水素ガス、原料ガ 30 ス発生器28にペンゼン、有機ケイ素化合物のガ ス発生器32にジエチルシランを入れて、先づ原 料ガス発生器28と有機ケイ素化合物のガス発生 器32を加熱してペンゼンとジェチルシランのガ スを発生させ、パルプ20,42を調節して流量 35 1160℃における均熱帯は300mmであつた。第1の 計18,40により所定量の水素、硫化水素を流 す。水素ガスはステンレスパイプ24よりパルプ 28を経て原料ガス発生器28に入り、ペンゼン ガスと混合されてステンレスパイプ30を経て有 機ケイ素化合物のガス発生器32に入り、ここに 40 て水素ーペンゼンージエチルシランの混合ガスを 発生し、ステンレスパイプ34よりパルプ38を 経て硫化水素と混合されて反応管38に入る。ペ ンゼンやジエチルシランがパイプ内に凝縮しない

ようにステンレスパイプ30は80℃に加熱した。 進合ガスの組成はHa: H:S: CaHa: (C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>3</sub>SiH<sub>3</sub>=90.4:3.1:25:40; 檢流量は25 ℃換算で111×1/分~222×1/分の範囲で変化させ 硫化水素と混合して反応管38に導入し、電気炉 5 た。電気炉50は1065℃の温度に設定した。反応 管38の内部の温度分布を調べたところ、均熱帯 はパイプの中央付近300元であった。この反応管 38で混合ガスが熱分解反応し、触媒と気相成長 炭素繊維が連続的に生成される。すなわち、混合 第2図は、第1図に示す装置にさらに付加し得 10 ガスは連続的に供給され、反応管38内で連続的 に熱分解し、触媒と気相成長炭素繊維が連続的に 生成する。さらにこの連続的に生成した炭素繊維 を連続的に加熱域から流出させ、連続的に捕集す ることができる。生成した気相成長炭素繊維は、 8に直結したものである。この場合、第2の反応 15 ステンレス繊維フイルタ58で捕集し、重量増加 分より収率を計算した。また炭素繊維の径、長さ については走査型電子顕微鏡で観察した。結果を 第1表に示す。ここで滞留時間は反応量の300元 の均熱帯を通過する時間として求め、総流量は25

		(1)	(2)	(3)
総流量 (山/分)		111	167	222
滞留時間	(秒)	0, 22	0, 15	0, 11
径	<b>(μ)</b>	0, 10	0. 10	0.10
長さ	(µ)	15.0	11.0	8,0
収率	(%)	51	36	27

第1表より長さはほぼ滞留時間に比例する。

第2図に示す装置により、実施例1で生成した 炭素繊維を、1160℃に加熱した第2の反応管 6 2 で更に径のコントロールを行つた。反応管 8 2の 反応では炭素供給量が少なかつたため、更に第2 図のポンペ84よりアセチレンガスを標準状態で 20元/分送った。その結果を第2表に示す。

	第1の炉	第1.+第2の炉
径×長さ(μ)	0.10×15.0	0.20×15.0
径×長さ(μ)	0.10×8.0	0.21×8.0

た。

第2表より第2の炉では径のみが成長したこと が分る。

#### 実施例 3

混合ガスとして水素ガス:ナフタレン:ヘキサ 山/分 (25℃換算)、電気炉温度1065℃の条件で 実施した。収率23%、0.10×13μ(径×長さ) の気 相成長炭素繊維が得られた。

#### 実施例 4

シラン:硫化水素ガス=91.0:5.0:4.0、給流量 110元/分(25℃換算)、電気炉温度1080℃の条件 で実施した。収率42%、0.10×16µの気相成長炭 素繊維が得られた。

#### 実施例 5

混合ガスとして水素ガス:トリメチルシリコン イソチオシアナート=85.0:5.0、給流量105元/ 分 (25℃換算)、電気炉温度1070℃の条件で実施 した。収率18%、0.11×10μの炭素繊維が得られ

#### 図面の簡単な説明

第1図は気相応長炭素繊維の製造に使用した実 メチルジシルチアン=83.5:1.7:48、給流量107 5 験装置の系統図、第2図は第1図の装置に接続す る第2の気相成長炭素繊維の製造に使用した実験 装置の系統図である。

12

10, 12, 14, 64……ガスポンペ、1 6, 18, 40, 68……流量計、20, 22, 混合ガスとして水素ガス:トリエチルフエニル 10 28, 38, 42, 48, 48, 68……パル ブ、28,32……ガス発生器、38……反応管 (第1)、50,72……電気炉、52,74…… 熱電対、54,78……3回路PID温度制御器、 15 5.6, 78……温度記録計、5.8, 80……ステ ンレス繊維フィルタ、80,82……排気パイ ブ、82……反応管(第2)。

